

# Mini Gamma 传感器问答

# O1: 应维持哪些条件以确保 mini Gamma 传感器保持在其有效工作范围内?

**A1:** Mini Gamma 传感器具有很长的使用寿命,这得益于其采用碘化铯晶体(一种高度稳定的材料)制造。它没有特殊的存储条件要求,可以在标准环境条件下存放,而不会有性能下降的风险。

# O2: Mini Gamma 传感器中使用的是哪种闪烁晶体?该晶体是脆性的还是吸湿性的?

A2: Mini Gamma 传感器使用的是铊掺杂碘化铯(CsI (Tl)),这是 X 射线和 γ 射线检测中最常用的闪烁体,因其高光输出和良好的稳定性。所有碘化铯(CsI)晶体都具有一定的脆性和吸湿性(对水分敏感)。其中,CsI (Tl) 的吸湿性最低,但仍应存放在干燥环境中,并避免与水或高湿度直接接触。如果晶体密封良好,通常的环境湿度是可以接受的。

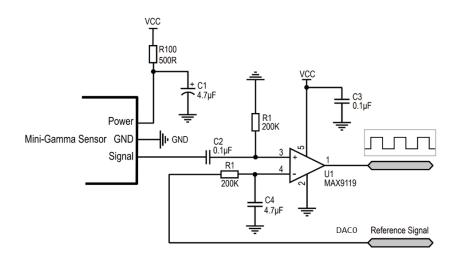
# Q3: Gamma 传感器导线的横截面尺寸和长度是多少?

A3: 导线为实心结构, 直径 0.45 毫米, 对应 AWG (美国线规) #25。套管直径为 0.8 毫米, 导线长度 如规格书所示为 72.0±5.0 毫米。

# Q4: Gamma 传感器内部的最大电容和电感是多少?

**A4:** 电路的最大总电容并非精确可知,但最大的单个电容器为 4.7 微法 (μF),位于电源部分。这是唯一该规格的电容器; 其他所有电容器均在纳法 (nF) 范围内,因此总电容小于 5 微法。电路不含任何电感元件,因此其整体电感实际上为零。

# Q5: Mini Gamma 传感器的推荐接口电路图是什么?



www.semeatech.com 第 1 页



**A5:** 碘化铯(CsI)Gamma 传感器的输出近似为高斯形状的脉冲,其幅度与传感器检测到的入射 γ 光子能量成正比。在大多数应用中,无需进行详细的能谱分析;因此,可以使用一个简单的甄别器电路(主要由 MAX9119 比较器和后续的计数系统组成)通过脉冲计数率来确定 γ 强度。

MAX9119 的反相输入端(引脚 4)接收由微控制器(MCU)的数模转换器(DAC)输出产生的阈值电压。只有幅度超过该阈值的传感器脉冲才会通过比较器;较小的脉冲(通常是噪声)会被阻断。后续的计数系统对通过的脉冲进行计数,并根据脉冲率计算γ剂量率。

引脚 4 的参考电压不应固定;必须根据传感器的电子噪声水平进行调整。您可以使用示波器测量此噪声水平。在没有任何放射源的情况下,观察噪声脉冲的幅度,并将阈值设置为略高于最大噪声峰值。

在没有辐射源的情况下,您将观察到一个以 0V 为中心的噪声脉冲带。该带的宽度对应于最大噪声幅度。超过此带的脉冲很可能是真实的 γ 辐射事件。通常,所有脉冲(无论幅度如何)都具有近似相同的半峰全宽(FWHM),这由传感器和放大器的时间常数决定。

# O6: 如何理解 mini Gamma 传感器电路及其原理?

**A6:** Mini Gamma 传感器输出类似高斯形状的脉冲,这是辐射探测系统中常见的波形。每个脉冲的幅度 (高度) 与传感器检测到的入射  $\gamma$  光子能量成正比,  $\gamma$  光子能量越高,脉冲幅度越大。

在大多数应用中,无需测量每个γ光子的确切能量。相反,系统专注于对探测事件进行计数,并通过脉冲计数率分析其强度。

甄别器电路用于滤除不需要的信号和电子噪声。MAX9119 比较器是该电路的关键组件。它将每个输入脉冲与由微控制器(MCU)的数模转换器(DAC)输出设定的阈值进行比较。该阈值定义了信号被识别为有效事件所需的最小脉冲幅度。

幅度高于阈值的脉冲通过比较器并被计数。幅度较低的脉冲(通常由噪声或微弱、无关事件引起) 被阻断,确保只有有意义的脉冲才会被分析。

在甄别器之后,计数系统收集有效脉冲并在规定的时间间隔内对其进行计数。然后,脉冲计数率被 用于计算γ剂量率,该剂量率表示γ辐射的强度。

Q7: 根据 mini Gamma 传感器电路图,MAX9119 的反相输入端(引脚 4)需要设置什么电压基准?

A7: MAX9119 引脚 4 的电压基准并非固定值,必须根据传感器电子噪声脉冲的幅度进行设置。该基

www.semeatech.com 第 2 页



准电压可调节,应根据传感器在其工作环境中的特定噪声水平进行定制。

为正确设置此基准电压,请在无辐射源的情况下测量传感器产生的噪声脉冲幅度。这可以通过示波器完成,示波器可让您观察电子噪声波形并确定最大噪声幅度。然后,应将阈值(基准电压)设置 为略高于此最大噪声水平,以确保只对真实的γ探测脉冲进行计数,同时有效抑制噪声。

# **Q8:** 按照推荐电路,在没有任何放射源相互作用时,典型的输出偏置是什么?

**A8:** 当没有放射源存在时,传感器输出通常有一个约 0.08V 至 0.12V 的小直流偏置。建议在传感器输出和后续电路(如 MAX9119 比较器)之间插入一个隔直(耦合)电容,以去除这个直流分量。隔直电容之后,信号的直流电平取决于施加在电容另一侧的偏置,用户可以根据其电路设计要求进行调整。

# Q9: 在 mini Gamma 传感器的推荐电路图中,设置比较器 DAC0 参考电压是否有指导原则?

**A9:** 对于 mini Gamma 传感器, DACO 设定点应配置在 60 毫伏 (mV) 左右, 以匹配此阈值。

#### Q10: CPS 与 FWHM 具体含义?

A10: CPS (每秒计数, Counts Per Second) 是量化传感器每秒探测到的γ光子数量的关键指标。这种实时测量值反映了辐射强度,并同时受传感器灵敏度与放射源强度的影响。CPS 表示传感器随时间记录单个γ光子相互作用(亦称"事件")的速率。较高的 CPS 值对应较强的辐射场或放射源,且与放射源活度及传感器距放射源的距离成正比。通过传感器校准阶段建立的转换系数,可将 CPS 读数校准为特定辐射剂量率单位,如微西弗/小时(μSv/h)或微伦琴/小时(μR/h),从而使 CPS 数值能够在辐射安全标准与暴露水平的框架内进行解读。

半峰全宽(FWHM,Full Width at Half Maximum)是界定 Gamma 传感器能量分辨率的关键参数,用于衡量其区分γ射线能量的能力。这一能力对识别特定同位素或放射源至关重要。FWHM 表示在γ射线能量峰最大值一半高度处测得的峰宽度,通常以千电子伏特(keV)等能量单位,或峰值中心值的百分比形式表示。FWHM 数值越低,意味着能量分辨率越优异,传感器越能精准分辨相邻的能量峰。该参数常被用于区分发射能量相近的γ射线同位素,并作为比较不同 Gamma 传感器分辨率性能的标准依据。此外,脉冲的半峰全宽 FWHM(以其最大高度一半处测量所得)无论脉冲大小如何都保持一致。这种一致性反映了脉冲形态具有统一性,对确保在不同振幅下获得可靠测量结果至关重要。

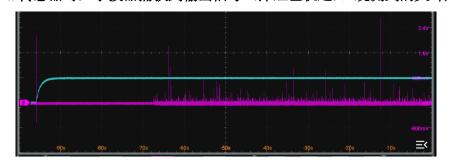
#### 011: 在设定时间内计数脉冲数量是否足以确定辐射强度,还是需要额外的处理步骤?

**A11**: 是的。在给定时间内检测到的脉冲数量与辐射强度成正比,计数的脉冲越多, $\gamma$ 辐射剂量率越高。

www.semeatech.com 第 3 页



- Q12: 当 mini Gamma 传感器检测到每分钟 14 个脉冲时,它指示的背景辐射水平是多少?
- **A12:** 如果 mini Gamma 传感器检测到每分钟 14 个脉冲,这对应于 14 微伦琴/小时( $\mu$ R/h)的背景辐射水平。
- O13: 对于处理准高斯脉冲,是否有推荐的特定时序或滤波算法?
- **A13:** 是的。由于传感器输出脉冲具有准高斯形状和随机到达时间,我们建议使用 200 毫秒的计数窗口来 捕获脉冲事件。然后,可以将若干连续窗口的读数在 1 至 2 秒内进行平均,以平滑短期统计波动,并产生稳定的辐射强度指示。
- Q14: 辐射强度超限时会产生何种现象? 传感器会饱和还是输出失准? 固件是否需要处理饱和场景? 若需要,推荐的应对方案是什么? 传感器是否需要特定的启动或预热时间,这一点是否应在固件中加以考虑?
- A14: 当辐射强度超过测量上限时,脉冲率会变得过高,单个脉冲可能开始重叠(脉冲堆积)。这会导致计数损失,从而低估实际辐射水平。在这种情况下,固件应检测到此状态并显示"饱和"或"超量程"警告,表明测量不再准确。上电后,传感器通常需要约 30 秒的稳定时间,读数才能变得稳定可靠。固件在报告有效剂量率数据之前,应考虑这段预热时间。
- O15: 测试 Gamma 传感器时,示波器捕获到输出信号(洋红色轨迹)。观测到的尖峰是否为正常现象?



- A15: 完全正确。尖峰表征 Gamma 传感器对放射源的响应。若充分扩展水平时基,每个尖峰均会呈现技术手册所示的拟高斯脉冲形态。
- O16: 按照推荐电路,什么幅度被视为有意义的输出,什么被视为噪声?
- **A16:** 在没有放射源的情况下,可以观察到一个由传感器电子噪声形成的脉冲噪声带。该带宽表示相对于 0V 的最大噪声幅度。幅度大于此噪声带的脉冲被视为有意义的信号,对应于实际的γ探测事件。

# 017: 输出脉冲宽度是否会随着幅度减小而变短?

www.semeatech.com 第 4 页



**A17:** 一般来说,所有脉冲无论其幅度如何,都具有近似相同的半峰全宽(FWHM)。通过测量不同幅度脉冲的半峰全宽,您会发现尽管脉冲高度不同,但宽度几乎保持恒定。

#### O18: 为什么传感器有时会显示高于预期的背景计数?

A18: 许多小脉冲源自电子噪声,而非实际的γ辐射事件。为抑制这些噪声脉冲,请增加施加到比较器反相输入端的基准电压(甄别阈值)。选择合适的阈值,使得在没有放射源的情况下不计数任何脉冲。此调整可确保所有噪声脉冲都被阻断。设置此阈值的过程称为甄别阈值校准。基准电压并非固定值,必须根据传感器电子噪声脉冲的幅度进行设置。您可以使用示波器测量噪声水平。在自然背景环境中(无辐射源),观察噪声脉冲的幅度,并将阈值设置为略高于最大噪声幅度。根据盛密科技的测试,典型阈值约为 0.08V。该传感器使用带超高增益前置放大器的 PIN 光电二极管,这也可能放大二极管的固有噪声。由于不同 PIN 二极管的噪声幅度存在差异,必须为每个传感器调整阈值。典型值范围为 0.06V 至 0.10V,尽管某些光电二极管可能需要略高或略低的阈值。

# Q19: 有什么方法可以防止计数损失的发生? 传感器是否有最大计数率(以 CPS 为单位),超过该计数率后传感器将不再有效?

**A19:** 在高辐射强度下,由于脉冲堆积(脉冲开始重叠且无法单独分辨),一定程度的计数损失是不可避免的。原则上,可以在固件或数据处理中应用二次校正函数,在一定程度上补偿这种非线性。未经校正时,可靠工作的最大计数率约为 1500 计数 / 秒(cps),此时测量精度约为 ±30%。使用这种紧凑型传感器通常难以实现优于 ±10% 的精度。作为比较,霍尼韦尔 GammaRAE II R 使用类似的碘化铯(CsI)晶体,但晶体体积约为 10 倍,其精度规格为 ±20%(参见用户手册: 霍尼韦尔 GammaRAE II R 手册)。

#### Q20: 如何解释 Gamma 传感器的线性回归?

A20: 线性回归是用于构建传感器输出值(每秒计数 CPS)与辐射水平关联模型的统计方法,可反映传感器输出随辐射强度增加遵循线性规律的贴合度。这有助于掌握传感器对不同辐射强度的响应特性。为评估线性度,会抽取一批传感器在不同辐射水平下测试,将测得数据绘制成数据点,拟合的线性回归线最能代表整批传感器的辐射响应特性,确保覆盖该批次所有传感器的线性度评估。在 95%置信水平下,该批次所有传感器的性能(测量计数率 CPS 与辐射强度的关系)均落在线性回归线±30%范围内,即传感器读数预期处于线性模型定义的理想响应值±30%偏差内。若将传感器基于回归线的线性特性整合到γ或 X 射线探测器等系统中,整个系统的测量精度将为±30%。

**CPS**(每秒计数, Counts Per Second) 指传感器每秒探测到的辐射事件计数,该指标可用于构建线性 回归模型。为抑制短期波动噪声,每个数据点通常取用一段时间内的平均 CPS 值。由于辐射探测的

www.semeatech.com 第 5 页



随机性导致 CPS 存在波动,需采用移动平均滤波器对数据平滑处理,以提升读数稳定性。滤波器窗口尺寸需根据 CPS 数值动态调整:

- 强辐射场:探测事件密集,单个数据点所需 CPS 样本量可减少;
- 高辐射环境(CPS>1000): 数据点分布密集,采用 2-3 点小窗口即可保持稳定性;
- 低辐射环境: 需扩大窗口集合足够数据, 保障读数稳定

滤波器窗口的具体尺寸最终取决于用户对读数稳定度的实际需求,故应采用动态可调机制而非固定值。

# Q21: 如何使用线性回归来评估 盛密科技 Gamma 传感器的线性度?

A21: 为评估线性度,我们通常从不同生产批次中选择约 30 个传感器样本,并将它们暴露于多种不同强度的辐射源下。我们将得到的计数 / 秒(CPS)与已知剂量率进行绘图,并应用线性回归来表征平均响应。根据我们的数据,95% 的传感器落在该回归线的 ±30% 范围内,这反映了当集成到更高层次的系统(如γ或 X 射线探测器)中时的预期线性度。由于固有的 CPS 波动,我们应用移动平均滤波器来稳定读数。滤波器窗口大小是自适应的:对于高 CPS(>1000),窄窗口(2-3 个点)就足够了;对于低 CPS,则需要更宽的窗口。确切的窗口大小取决于用户的稳定性要求。未经筛选的传感器之间的差异在 ±15% 以内。在低辐射水平下(例如,低 GBq 源),由于有限的 CPS 统计量,可能会出现更大的差异。

# Q22: 温度是否影响盛密科技 Gamma 传感器输出?若有影响,如何进行校准?

A22: γ光子因高能量特性及辐射探测的物理本质,其检测过程对温度不敏感。在-20℃至60℃工作温度范围内,环境温度变化对碘化铯晶体的γ光子探测效率及光电转换脉冲幅度无显著影响。

但温度会显著影响光电二极管性能: 40°C 以上时, 硅 PIN 光电二极管噪声幅值急剧增大; 50°C 时, 噪声可能湮没低能量 γ 射线产生的脉冲。从高温环境转入低温环境时,噪声随热平衡建立而衰减, 反之亦然。若未实施温度补偿,脉冲计数率在高温转低温时降低,低温转高温时升高。

对于 3cc Gamma 传感器采用的 Hamamatsu S5106 光电二极管,温度升高会使性能差异加剧:相同剂量率下,不同传感器可能输出 100 脉冲(对应 30μREM/hr)或 150 脉冲。该光电二极管对环境温度高度敏感,超过 40℃ 时尤为显著,因此 Gamma 传感器安装到监测仪后,必须进行针对性校准,且监测仪需配备热敏电阻实现温度补偿。

值得注意的是,温度校准无需放射源,而是通过分析不同工况下的噪声特性,验证传感器全温区性能。脉冲幅度甄别器常用于分离辐射脉冲与噪声,其阈值通常设定为光电二极管的噪声高度。但温

www.semeatech.com 第 6 页



度升高导致噪声幅值增加时,需提升甄别等级,这可能屏蔽部分低能量 γ 光子脉冲,造成应用系统 (非传感器本身) 计数率降低。

由于噪声与温度的关系无固定量化指标,且各光电二极管性能存在差异,每支传感器均需在实际应用中校准。环境温度达 35℃ 时,热噪声会干扰辐射信号输出,此时需采用更强放射源获取清晰输出。探测到脉冲(此时计数较低)后,需通过补偿算法维持输出线性。镅-241(Am-241)源强度不足,建议改用铯-137(Cs-137)源。

校准传感器时,首先需在无铯-137放射源状态下测定其基线噪声水平。记录基线数据后,引入铯-137源并测量传感器响应,从而确定相对于本底水平的输出变化。

### **Q23**: 如何理解 Gamma 传感器中的二次函数 (aX²+bX+c)?

**A23:** 系统级校准对于确保 Gamma 传感器的性能精准至关重要。若未经过适当校准,用户可能会获得不可靠的读数,因为每个传感器都可能存在个体差异。因此,必须通过单独校准来实现精确测量。

在校准过程中,系统会在多个测量点采集数据,将传感器输出值与已知参考基准进行比对。这些数据点随后被绘制在图表上。为精确表征传感器的响应特性,需要采用数学曲线——具体为二次函数 (aX²+bX+c)——对数据点进行拟合。应用二次函数拟合后,传感器的实际读数应当以±10%的可接受误差范围紧密贴合曲线。这意味着传感器读数的预期偏差通常不超过二次函数模型预测值的10%。

由于每个传感器都具有独特性状,因此需要为其建立专属的二次函数模型,该模型能在系统层级最精确地拟合其校准数据。这意味着每个传感器的校准曲线都具有排他性,即便是相同型号的传感器,其校准曲线也不能互换使用。

# Q24: 为何校准或相关性(CoC - Calibration or Correlation)数据中传感器间差异显著?

**A24**: 每个传感器相对于辐射源的定位存在微小差异,就会导致计数率(CPS)出现明显变化。受几何灵敏度和角度灵敏度影响,即使是微小的位置偏移,也会显著改变探测到的辐射强度。此外,在强辐射场中,部分传感器可能发生脉冲重叠(堆积),进而造成计数损失。当两个或多个脉冲重叠并被记录为单个事件时,固定时间段内的总计数会被低估。

传感器的脉冲宽度也可能因电子元件的公差而存在个体差异。产生较宽脉冲的传感器更容易出现饱和与脉冲重叠现象,这会进一步加剧测量差异。而在低辐射场中,脉冲重叠的可能性大幅降低,脉冲在时间上保持良好分离,因此传感器间的读数一致性更高。

www.semeatech.com 第 7 页



# Q25: 为何 mini Gamma 传感器长期使用后有时会出现灵敏度下降?

A25: 灵敏度下降的可能原因包括: (1) 寒冷环境: 在低温条件下(尤其是冬季), Gamma 传感器的灵敏度可能降低。极端低温会影响传感器元件的物理和电子特性,削弱其准确探测γ射线的能力。(2) 放射源半衰期: mini Gamma 传感器采用铯 -137 (Cs-137) 作为内置校准源,其半衰期约为 16 年。传感器的灵敏度与该放射源的活度直接相关,因此传感器长期使用后,其输出会随放射源衰变而成比例逐渐下降。建议采取的措施: (1) 根据 Cs - 137 的半衰期,核实该放射源是否仍在有效使用期内。(2) 使用一组"标准样品传感器"(经校准的参考传感器)进行定期比对测试,助力发现灵敏度偏差,确保长期测量准确性。

# Q26: 如何减轻电磁干扰 (EMI) 对 mini Gamma 传感器的影响?

A26: 盛密科技的 3cc Gamma 传感器采用双层电磁屏蔽设计,而 mini Gamma 传感器仅配备单层屏蔽。为降低电磁干扰敏感性,建议优化 mini Gamma 传感器的屏蔽设计,可考虑以下措施: (1) 双层屏蔽:增加第二层屏蔽,在两层屏蔽间保留微小间隙或插入非导电介质,避免电耦合,提升电磁干扰衰减效果。(2) 无缝外壳: 确保屏蔽外壳为全包裹式连续金属结构,无接缝或开口,防止高频干扰穿透。(3) 线缆屏蔽:对电源线和信号线进行妥善屏蔽与接地,最大限度减少电磁干扰通过线路侵入。

# Q27: Gamma 传感器是否存在"死区时间"?

**A27:** 死区时间是电子学理论中的一个专业概念。由于光信号逐渐衰减,光子会在探测器形成长尾波形。 计数率升高时,后续脉冲与前一脉冲尾部重叠的概率增加,因此,两个或多个信号可能会合并成一 个信号,导致记录到的计数少于实际入射光子数。辐射越强,计数偏差越大,这也解释了

为何探测器的计数率会随辐射强度升高而出现增长放缓的现象。与其他从事 Gamma 传感器设计生产的企业一样,盛密科技缺乏直接测量该参数的设备。建议通过计数率与辐射强度的关系构建数学模型,可将测量上限提升至  $15,000\,\mu\text{R/hr}$  (精度 $\pm 30\%$ ),若仅采用标准二次曲线拟合,测量上限约为  $8,000\,\mu\text{R/hr}$ ,且精度难以保障。

www.semeatech.com 第 8 页